

	<p><b>SI4922BDY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4922BDY-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4922BDY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2745 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


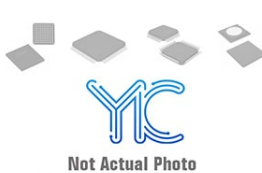
### Spezifikationen

Teilenummer	SI4922BDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2745 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2070pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SI4922BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4922BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4922BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4922BDY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4922BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4922DY-E3</b> VISHAY VISHAY NA</p>	 <p><b>SI4922BDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4922BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4922DY-T1</b> VISHAY SI4922DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4921DY-T1-E3</b> VISHAY SI4921DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4922BDY</b> SI SI4922BDY SI</p>	 <p><b>SI4922DY-T1-E3 SOP8</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>

### SI4922BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	SI4922BDY-T1-GE3	SI4922BDY-T1-GE3	SI4922BDY-T1-GE3	SI4922BDY-T1-GE3
SI4922BDY-T1-GE3 / Siliconix	SI4922BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4922BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4922BDY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4922BDY-T1-GE3
SI4922BDY-T1-GE3 Electronic	SI4922BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4922BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4922BDY-T1-GE3-Bild	SI4922BDY-T1-GE3-Teil
SI4922BDY-T1-GE3 Preis	SI4922BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4922BDY-T1-GE3 Bild	SI4922BDY-T1-GE3 Aktie	SI4922BDY-T1-GE3 Inventar
SI4922BDY-T1-GE3 Neu	SI4922BDY-T1-GE3 Original	SI4922BDY-T1-GE3 garantiert	SI4922BDY-T1-GE3 RFQ	SI4922BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited